

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
главного научного сотрудника – заведующего лабораторией
в лаборатории Диффузии и дефектообразования в полупроводниках
Вакансия VAC_26768

Тематика исследований

Исследования оптических (люминесцентных) свойств твердых тел при высокоэнергетическом возбуждении, в том числе нанокompозитов и наногетероструктур и разработка эффективных излучателей света на их основе.

Трудовая деятельность

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке аспирантов и специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство курсовыми работами, бакалаврскими, магистратскими и кандидатскими диссертациями, чтение лекций).

Особенности трудовой деятельности: главный научный сотрудник – заведующий лабораторией Диффузии и дефектообразования в полупроводниках несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Диффузии и дефектообразования в полупроводниках на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени доктора физико-математических наук.
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus (шт.): не менее 130, Web of Science (шт.): не менее 130, РИНЦ не менее 150. Российский индекс научного цитирования не менее 700 (число цитирований), число цитирований на одну публикацию не менее 5
- Индекс Хирша по версии Web of Science (Scopus) не ниже 11.
- Опыт научной работы не менее 20 лет.
- Опыт научно-организационной работы не менее 9 лет.

За последние 5 лет руководство не менее чем 3 договорами с научно-производственными организациями-заказчиками, руководство не менее чем 3 грантами отечественных и зарубежных научных фондов; подготовка научных кадров высшей квалификации - обучение не менее 3 аспирантов.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).